

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載  
 【部門区分】第3部門第4区分  
 【発行日】平成17年5月19日(2005.5.19)

【公開番号】特開2000-313960(P2000-313960A)  
 【公開日】平成12年11月14日(2000.11.14)  
 【出願番号】特願平11-120523  
 【国際特許分類第7版】

C 2 3 C 16/448

C 2 3 C 16/455

C 0 1 G 19/02

【F I】

C 2 3 C 16/44 C

C 2 3 C 16/44 D

C 0 1 G 19/02 C

【手続補正書】

【提出日】平成16年7月14日(2004.7.14)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

スズの無機塩および水を含む原料ガスをインジェクタより基体表面に向けて供給し、CVD法により、基体上に酸化スズ膜を成膜する方法において、原料ガスをインジェクタの吹出し口より供給すると同時に、臭化水素を供給する酸化スズ膜の成膜方法。

【請求項2】

スズの無機塩および水を含む原料ガスをインジェクタ中央部から基体に向けて供給し、原料ガスの外側から臭化水素を供給する請求項1に記載の酸化スズ膜の成膜方法。

【請求項3】

臭化水素を、原料ガスを排気する排気口付近から供給する請求項1または2に記載の酸化スズ膜の成膜方法。

【請求項4】

原料ガスと接するインジェクタの表面部分の温度を400以下とする請求項1～3いずれか1項に記載の酸化スズ膜の成膜方法。

【請求項5】

原料ガス中のスズの無機塩に対して、臭化水素をモル比で0.1～4の割合で供給する請求項1～4いずれか1項に記載の酸化スズ膜の成膜方法。